B 340 D · B 341 D · B 342 D

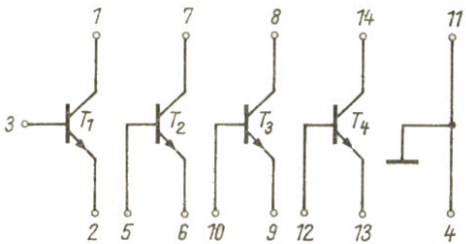
Integrierte Transistorarrays mit vier Si-npn-Transistoren

Bauform 5

Anschlußbelegung

1	Kollektor T1	8	Kollektor T3
2	Emitter T1	9	Emitter T3
3	Basis T1	10	Basis T3
4	Masse	11	Masse
5	Basis T2	12	Basis T4
6	Emitter T2	13	Emitter T4
7	Kollektor T2	14	Kollektor T4

Innere Schaltung



Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spannung	U_{CEO}	15 V
Kollektor-Basis-Spannung	U_{CBO}	20 V
Emitter-Basis-Spannung	U_{EBO}	5 V
Kollektor-Substrat-Spannung	U_{CIO}	30 V
Kollektorstrom	I_C	10 mA
Basisstrom	I_B	5 mA
Wärmewiderstand für Gesamt I_S	R_{thja}	120 K W
Betriebstemperaturbereich	ϑ_a	—25 . . . 85 °C
Sperrschichttemperatur	ϑ	125 °C

Kennwerte bei $\vartheta_a = 25\ °C \pm 5\ K$

Gleichstromverstärkung $U_{CB} = 5\ V,\ I_E = 1\ mA$	$h_{21\,E(T1)}$		c 56 . . . 140 d 112 . . . 280 e 224 . . . 560
$U_{CB} = 5\ V,\ I_E = 10\ \mu A$	$h_{21\,E}$	c, d, e	30
Verhältnis der Gleichstromverstärkung für alle möglichen Transistorpaare $U_{CB} = 5\ V,\ I_E = 1\ mA$	$\frac{h_{21E(x)}}{h_{21E(y)}}$		0,8 . . . 1,25
Differenz der Basis-Emitter-Spannungen für alle möglichen Transistorpaare (nur B 340/341) $U_{CB} = 5\ V,\ I_E = 100\ \mu A$	U_B		$\leq$ 5 mV
Übergangsfrequenz $U_{CE} = 5\ V,\ I_C = 1\ mA,\ f = 100\ MHz$	f_T		135 MHz
Rauschfaktor für B 341 D $I_C = 200\ \mu A,\ f = 1\ kHz,\ \Delta f = 100\ Hz,\ R_G = 2\ k\Omega$	F		$\leq$6 dB